工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

111 年度工研院電光系統所
半導體光源、電子構裝與平面顯示技術等相關研發成果讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

■本讓與案包含半導體光源、電子構裝與平面顯示技術等相關研發成果專利共 97 案 203 件（以下簡稱：「讓與標的」）。「讓與標的」共分為：（一）半導體光源技術 40 案 84 件，（二）半導體電子構裝技術 26 案 67 件，（三）平面顯示技術 20 案 38 件，（四）軟性電子 11 案 14 件。「讓與標的」中與第三人共有之比例，均已標示。請投標廠商留意：「讓與標的」中之案次第 71、73、86 案，本次僅讓與本院應有部分，得標廠商將與他人共有該專利。

「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

（一）公開說明會將於民國（下同） 111 年 9 月 13 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。

（二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 111 年 9 月 12 日 12 時整(含)前發送電子郵件(請於電子郵件主旨上註明「半導體光源、電子構裝與平面顯示技術等相關研發成果讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 111 年 9 月 12 日 17 時整(含)前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

（三）自本讓與案公告日起至截標日 111 年 9 月 28 日 17 時整(含)止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

（一）本讓與案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項

目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同(1)密封（價格封），連同(2)押標金、(3)公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、(4)近兩年財報資料、(5)公司基本資料暨運用規劃說明表及(6)商業營運計畫書一式 7 份(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「半導體光源、電子構裝與平面顯示技術等相關研發成果讓與案投標」，於截標日 111 年 9 月 28 日 17 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：

310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工研院技轉法律中心 李小姐收

（二）廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表中敘明境外實施金額。

（三）商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1.公司背景/關係企業/合作夥伴簡介（20%）

2.公司財務狀況（20%）

3.公司營運/研發能力（20%）

4.讓與標的運用規劃（30%）

5.國內產業效益（10%）（例如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等）

（四）投標方式：

■本讓與案採「案」方式投標。「讓與標的」以同一發明為一案。本讓與案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。

（五）本讓與案不得共同投標或重複投標。

（六）投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

（七）投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

（一）押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。

（二）押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。

（三）得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

（一）投標時間截止後之投標。

（二）開標前業已公告停止本讓與案交易程序。

（三）投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。

（四）投標單附加任何成交條件者。

（五）投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。

（六）投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

（七）投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果（包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果）轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及/或工研院同意者，不在此限。

（八）投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方法：

（一）分為初審（開標日為 111 年 9 月 29 日）及複審（決標日為 111 年 10 月 18、19 日），投標廠商於通過初審後，始能進入複審。會另行通知投標廠商，請廠商依通知時間進行複審。

（二）得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。

（三）初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、商業營運計畫書進行書面審查及確認。

（四）投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會議就商業營運計畫書進行複審，投標廠商於決標日應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔及書面文件。

（五）投標廠商若有境外實施需求，除於公司基本資料暨運用規劃表中敘明境外實施金額，並於複審時報告說明。

（六）複審時，工研院開標審議委員會議將同時開啟超過及格分之所有投標廠商底價單，將以投標廠商金額最高且高於底價者得標。若投標廠商出價皆無超過底價，則出價金額最高之廠商可優先有一次加價機會，若此加價仍無超過底價，之後則由所有投標廠商同時議價，所有投標廠商間的同時比增價格以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二（含）家以上投標廠商總評比分數均超過及格分，投標金額亦均超過底價且相同，得提供投標廠商議價機會，並以高價者決標。比增價格以三次為限，若比增三次後之投標金額仍相同者，由工研院現場抽籤決定之。（議價時，若非投標廠商負責人出席，須填妥並提供委託代理授權書）。

（七）決標時將請律師到場監標。

（八）決標後將個別通知投標廠商決標結果（不公告得標廠商）。

（九）對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。

九、契約事項：

（一）得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。

（二）得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

（三）得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。

（四）遵守政府法令規定：

■得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定）。前述法令變動時，亦同。

（五）得標廠商應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。

（六）得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本讓與案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。「讓與契約書」生效日：

■「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部及共有人同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部及共有人之意見並無影響能力。

（七）反授權約定：

■得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予經濟部或工研院。得標廠商嗣後若將「讓與標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人（以下簡稱「後手」）時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」再為專屬授權或讓與時亦同。

（八）得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：

1.工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；

2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及

3.工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。

（九）得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本讓與案公告日之「讓與標的」現狀辦理本讓與案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

（十）「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。

（十一）「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之政府法令規定，配合工研院向主管機關（包含但不限於經濟部技術處，以下同）為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及/或主管機關核准及同意後始得為之：

1.得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；

2.得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

3.得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

4.得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

（十二）得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

1.得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

2.得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。

3.為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及/或工研院亦無須負擔損害賠償責任。

（十三）得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及/或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。此外，若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與或輾轉讓與「讓與標的」予非專利實施實體（Non- Practicing Entity，以下簡稱「NPE」），或未經工研院及/或經濟部同意之受讓者（以下簡稱「未經同意之受讓者」），造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「讓與標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及/或工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與後手之讓與契約，否則即視為將「讓與標的」讓與予「NPE」或「未經同意之受讓者」。

（十四）得標廠商應使所有「後手」遵守本條第七項至第九項、第十一項至第十六項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

（十五）基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

（十六）得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主

要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

（十七）得標廠商應盡力進行產品開發等運用「讓與標的」工作，倘得標廠商未能舉證於合理期間內有效運用「讓與標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本讓與案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本讓與案公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本讓與案公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心 李小姐

電話：+886-3-5912374

傳真：+886-3-5820466

電子信箱：lee0371@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：專利清單

（一）半導體光源技術：40 案 84 件

案次	件次	案編號	件編號	中文專利名稱	國家	公告號	專利種類	專利起期	專利迄期	狀態	本案讓與專利權比例	契約運用
1	1	P08910049	P08910049CN	發光二極管組件及其制造方法	中國大陸	CN1317774	發明	20070523	20230211	獲證	100%	
	2	P08910049	P08910049DE	發光二極體元件及其製造方法	德國	DE10322705A1	發明	20060706	20230519	獲證	100%	
	3	P08910049	P08910049JP	發光二極體元件及其製造方法	日本	4148846	發明	20080704	20230623	獲證	100%	
	4	P08910049	P08910049TW	發光二極體元件及其製造方法	中華民國	565957	發明	20031211	20221212	獲證	100%	
	5	P08910049	P08910049US	發光二極體元件及其製造方法	美國	6969627	發明	20051129	20230512	獲證	100%	
2	6	P08930038	P08930038TW	發光二極體與其製造方法	中華民國	I241038	發明	20051001	20240913	獲證	100%	V
	7	P08930038	P08930038US	發光二極體與其製造方法	美國	7339197	發明	20080304	20250720	獲證	100%	V
3	8	P08930081	P08930081CN	發光二極管封裝結構及其制造方法	中國大陸	CN100438098	發明	20081126	20250712	獲證	100%	
	9	P08930081	P08930081KR	發光二極體封裝結構及其製造方法	韓國	10-0624123	發明	20060907	20250809	獲證	100%	
	10	P08930081	P08930081TW	發光二極體封裝結構及其製造方法	中華民國	I248218	發明	20060121	20241230	獲證	100%	V
	11	P08930081	P08930081US	發光二極體封裝結構及其製造方法	美國	7589354	發明	20090915	20251125	獲證	100%	
4	12	P08940014	P08940014CN	發光裝置	中國大陸	CN100499188	發明	20090610	20251009	獲證	100%	
	13	P08940014	P08940014JP	發光裝置	日本	4825095	發明	20110916	20260926	獲證	100%	
	14	P08940014	P08940014KR	發光裝置	韓國	10-0863612	發明	20081008	20260817	獲證	100%	
	15	P08940014	P08940014TW	發光裝置	中華民國	I274430	發明	20070221	20250927	獲證	100%	V
	16	P08940014	P08940014USD1	發光裝置	美國	8017964	發明	20110913	20260507	獲證	100%	
5	17	P08940038	P08940038CN	條狀側射式光導結構與面光源模塊	中國大陸	CN100434991	發明	20081119	20250907	獲證	100%	
	18	P08940038	P08940038TW	條狀邊射式光導結構與面光源模組	中華民國	I323373	發明	20100411	20250905	獲證	100%	
	19	P08940038	P08940038US	條狀邊射式光導結構與面光源模組	美國	7325960	發明	20080205	20260328	獲證	100%	
6	20	P08940049	P08940049CN	功率型封裝件及其制造方法	中國大陸	CN100524854	發明	20090805	20251013	獲證	100%	
	21	P08940049	P08940049TW	功率型封裝件及其製法	中華民國	I281266	發明	20070511	20251006	獲證	100%	V
7	22	P51000012	P51000012CN	照明裝置	中國大陸	CN102927462	發明	20141126	20310908	獲證	100%	
	23	P51000012	P51000012TW	照明裝置	中華民國	I422784	發明	20140111	20310811	獲證	100%	
8	24	P51000045	P51000045TW	照明裝置及其組裝方法	中華民國	I468621	發明	20150111	20320301	獲證	100%	V
	25	P51000045	P51000045TWA1	發光二極體燈具	中華民國	D156274	設計	20131001	20270830	獲證	100%	
	26	P51000045	P51000045US	照明裝置及其組裝方法	美國	8926130	發明	20150106	20320823	獲證	100%	V
	27	P51000045	P51000045USA1	發光二極體燈具	美國	D685508	設計	20130702	20270701	獲證	100%	

案次	件次	案編號	件編號	中文專利名稱	國家	公告號	專利種類	專利起期	專利迄期	狀態	本案讓與專利權比例	契約運用
	28	P51000045	P51000045USC1	發光二極體燈具	美國	D728833	設計	20150505	20290504	獲證	100%	
9	29	P51000096	P51000096TW	半導體光源裝置	中華民國	I471505	發明	20150201	20311228	獲證	100%	
	30	P51000096	P51000096US	半導體光源裝置	美國	8979313	發明	20150317	20330711	獲證	100%	
10	31	P51000098	P51000098TW	發光二極體封裝結構	中華民國	I514630	發明	20151221	20311229	獲證	100%	
11	32	P51000134	P51000134TW	模組化照明裝置與光源模組	中華民國	I465666	發明	20141221	20320109	獲證	100%	
	33	P51000134	P51000134US	模組化照明裝置與光源模組	美國	8814418	發明	20140826	20330113	獲證	100%	
12	34	P51000140	P51000140CN	染料標示型高分子、聚光板及其形成方法、太陽能電池模組及免插電燈具	中國大陸	CN103183971	發明	20160803	20321226	獲證	100%	
	35	P51000140	P51000140TW	內埋式螢光柱聚光板、其形成方法及太陽能電池模組	中華民國	I469378	發明	20150111	20311229	獲證	100%	V
13	36	P51000152	P51000152US	控制光伏裝置交流輸出的方法與交流光伏裝置	美國	9148021	發明	20150929	20340517	獲證	100%	
14	37	P51000161	P51000161TW	照明裝置、光源結構與光源模組	中華民國	I465667	發明	20141221	20320301	獲證	100%	
	38	P51000161	P51000161US	照明裝置、光源結構與光源模組	美國	8764228	發明	20140701	20321224	獲證	100%	
15	39	P51000164	P51000164US	發光二極體光源	美國	8764231	發明	20140701	20321125	獲證	100%	
16	40	P51000167	P51000167CN	面光源以及可撓性面光源	中國大陸	CN103133918	發明	20151111	20320808	獲證	100%	
	41	P51000167	P51000167TW	面光源以及可撓性面光源	中華民國	I497016	發明	20150821	20320418	獲證	100%	V
	42	P51000167	P51000167US	面光源以及可撓性面光源	美國	8915634	發明	20141223	20320824	獲證	100%	V
17	43	P51010050	P51010050TW	發光二極體結構、發光二極體封裝與發光二極體結構之溫度的量測方法	中華民國	I482310	發明	20150421	20321212	獲證	100%	
18	44	P51010051	P51010051TW	半導體元件之檢測方法及其檢測系統	中華民國	I465736	發明	20141221	20321010	獲證	100%	
	45	P51010051	P51010051US	半導體元件之檢測方法及其檢測系統	美國	9726713	發明	20170808	20350825	獲證	100%	
19	46	P51010107	P51010107TW	薄膜發光二極體裝置	中華民國	I479652	發明	20150401	20321223	獲證	100%	
20	47	P51010112	P51010112TW	噴氣系統及氣相磊晶設備	中華民國	I480414	發明	20150411	20321113	獲證	100%	
21	48	P51010116	P51010116TW	多光耦合裝置	中華民國	I486144	發明	20150601	20321225	獲證	100%	
22	49	P51010169	P51010169TW	發光二極體晶圓及其製造方法	中華民國	I513051	發明	20151211	20330507	獲證	100%	
23	50	P51020059	P51020059USD1	發光二極體封裝結構	美國	9231168	發明	20160105	20340501	獲證	100%	
24	51	P51060038	P51060038TW	照明控制系統及照明控制方法	中華民國	I647976	發明	20190111	20371129	獲證	100%	
25	52	P51960039	P51960039TW	光電混載電路板及其製造方法	中華民國	I393509	發明	20130411	20270703	獲證	100%	

案次	件次	案編號	件編號	中文專利名稱	國家	公告號	專利種類	專利起期	專利迄期	狀態	本案讓與專利權比例	契約運用
26	53	P51960105	P51960105CN	發光二極管壽命試驗裝置及方法	中國大陸	CN101452044	發明	20110126	20271206	獲證	100%	
	54	P51960105	P51960105TW	發光二極體壽命試驗裝置及方法	中華民國	I345067	發明	20110711	20271122	獲證	100%	
	55	P51960105	P51960105US	發光二極體壽命試驗裝置及方法	美國	7888942	發明	20110215	20281120	獲證	100%	
27	56	P51960156	P51960156CN	照明裝置	中國大陸	CN101532637	發明	20121107	20280312	獲證	100%	
	57	P51960156	P51960156TW	照明裝置	中華民國	I336386	發明	20110121	20280306	獲證	100%	
	58	P51960156	P51960156US	照明裝置	美國	8449149	發明	20130528	20290614	獲證	100%	
28	59	P51970062	P51970062TWC1	發光二極體之 PN 接面溫度的測試方法	中華民國	I404923	發明	20130811	20281201	獲證	100%	
	60	P51970062	P51970062US	交流發光二極體 PN 接面之溫度測試方法	美國	7982486	發明	20110719	20290701	獲證	100%	
29	61	P51970085	P51970085TW	光波導結構及其製造方法	中華民國	I393928	發明	20130421	20281118	獲證	100%	
30	62	P51970088	P51970088TW	發光二極體晶片及其製作方法	中華民國	I446571	發明	20140721	20281013	獲證	100%	
31	63	P51980063	P51980063TW	照明裝置	中華民國	I400410	發明	20130701	20291214	獲證	100%	
	64	P51980063	P51980063US	照明裝置	美國	9347640	發明	20160524	20340110	獲證	100%	
32	65	P51980083	P51980083CNC1	發光二極管封裝接口的檢測裝置及方法	中國大陸	CN102183546	發明	20141224	20310113	獲證	100%	
	66	P51980083	P51980083TWC1	發光二極體封裝界面之檢測裝置及方法	中華民國	I469236	發明	20150111	20301208	獲證	100%	
33	67	P51980133	P51980133CN	晶片級發光二極體結構的製造方法及發光二級管芯片	中國大陸	CN103187491	發明	20170322	20320201	獲證	100%	
	68	P51980133	P51980133TW	晶圓級發光二極體結構、發光二極體晶片及其製造方法	中華民國	I502769	發明	20151001	20310102	獲證	100%	V
	69	P51980133	P51980133TWA1	晶圓級發光二極體結構之製造方法	中華民國	I466327	發明	20141221	20311228	獲證	100%	V
	70	P51980133	P51980133US	晶圓級發光二極體結構、發光二極體晶片及其製造方法	美國	9178107	發明	20151103	20330622	獲證	100%	V
34	71	P51980140	P51980140CN	背光模塊、面光源模塊及導光網格結構	中國大陸	CN102261602	發明	20131009	20300527	獲證	100%	
35	72	P51980146	P51980146TW	照明裝置	中華民國	I402456	發明	20130721	20300316	獲證	100%	
36	73	P51980148	P51980148CN	發光二極管晶片、發光二極管封裝結構、及用以形成上述的方法	中國大陸	CN103222073	發明	20170329	20300802	獲證	100%	
	74	P51980148	P51980148CNA1	發光二極管晶片、發光二極管封裝結構、及其形成方法	中國大陸	CN103180979	發明	20160803	20310802	獲證	100%	
	75	P51980148	P51980148TW	發光二極體晶片、包含其之封裝結構以及其製造方法	中華民國	I422065	發明	20140101	20301230	獲證	100%	V

案次	件次	案編號	件編號	中文專利名稱	國家	公告號	專利種類	專利起期	專利迄期	狀態	本案讓與專利權比例	契約運用
	76	P51980148	P51980148USA3	發光二極體晶片、包含其之封裝結構以及其製造方法	美國	8759865	發明	20140624	20310802	獲證	100%	
37	77	P51990026	P51990026CN	檢測系統及檢測方法	中國大陸	CN102540039	發明	20150121	20310216	獲證	100%	
	78	P51990026	P51990026TW	檢測系統及檢測方法	中華民國	I451101	發明	20140901	20310102	獲證	100%	
	79	P51990026	P51990026US	檢測系統及檢測方法	美國	8773158	發明	20140708	20320525	獲證	100%	
38	80	P51990035	P51990035CN	光色調制方法及發光二極管光源模塊	中國大陸	CN102458019	發明	20140122	20301228	獲證	100%	
	81	P51990035	P51990035TWC1	光色調制方法、發光二極體光源模組及其封裝結構	中華民國	I452670	發明	20140911	20310123	獲證	100%	
39	82	P51990087	P51990087US	懸浮式空橋氮化物半導體異質基板結構	美國	8674393	發明	20140318	20320512	獲證	100%	
40	83	P51990126	P51990126CN	具有多種光形輸出的發光二極管的燈具光源	中國大陸	CN102829416	發明	20150722	20311228	獲證	100%	V
	84	P51990126	P51990126TWC1	具有多種光形輸出的發光二極體的燈具光源	中華民國	I504015	發明	20151011	20320402	獲證	100%	

（二）半導體電子構裝技術 26 案 67 件。

案次	件次	案編號	件編號	中文專利名稱	國家	公告號	專利種類	專利起期	專利迄期	狀態	本案讓與專利權比例	契約運用
41	85	P03920088	P03920088US	微型熱電冷卻裝置之結構及製造方法	美國	8426720	發明	20130423	20290517	獲證	100%	
42	86	P03920104	P03920104TW	非對稱電極之內藏電容裝置與製程	中華民國	I314745	發明	20090911	20240201	獲證	100%	
43	87	P03940086	P03940086CN	具有多層結構之埋入式電容核	中國大陸	CN101035406	發明	20110413	20260918	獲證	100%	
	88	P03940086	P03940086TW	電容元件及其形成方法與形成埋入式電容核板的方法	中華民國	I365014	發明	20120521	20260911	獲證	100%	
	89	P03940086	P03940086US	電容元件及其形成方法與形成埋入式電容核板的方法	美國	7893359	發明	20110222	20290531	獲證	100%	
44	90	P03940090	P03940090CN	具有共享耦合區的埋入式電容元件	中國大陸	CN1937884	發明	20101208	20260918	獲證	100%	
	91	P03940090	P03940090TW	具有共用連接區域之埋入式電容裝置	中華民國	I340454	發明	20110411	20260917	獲證	100%	
	92	P03940090	P03940090US	具有共用連接區域之埋入式電容裝置	美國	7875808	發明	20110125	20290223	獲證	100%	
45	93	P03940091	P03940091TW	高介電係數之天線基板及其天線	中華民國	I351130	發明	20111021	20251229	獲證	100%	
	94	P03940091	P03940091USC1	高介電係數之天線基板及其天線	美國	8018397	發明	20110913	20280202	獲證	100%	
46	95	P03940292	P03940292CN	電容結構	中國大陸	CN101047063	發明	20101013	20260329	獲證	100%	
	96	P03940292	P03940292TW	電容結構	中華民國	I273613	發明	20070211	20260320	獲證	100%	
47	97	P51000113	P51000113CN	芯片封裝結構	中國大陸	CN103187372	發明	20160330	20321223	獲證	100%	
	98	P51000113	P51000113TW	晶片封裝結構	中華民國	I463633	發明	20141201	20311229	獲證	100%	
	99	P51000113	P51000113US	晶片封裝結構	美國	8866309	發明	20141021	20330421	獲證	100%	
48	100	P51000118	P51000118TW	固態電解電容基板模組及包括該固態電解電容基板模組的電路板	中華民國	I483352	發明	20150501	20320311	獲證	100%	
	101	P51000118	P51000118US	固態電解電容基板模組及包括該固態電解電容基板模組的電路板	美國	9030808	發明	20150512	20330611	獲證	100%	
49	102	P51000168	P51000168CN	自組裝設備、使元件自組裝的方法以及熱電元件組裝方法	中國大陸	CN103390722	發明	20150916	20320620	獲證	100%	
	103	P51000168	P51000168TW	自組裝設備、使元件自組裝的方法以及熱電元件組裝方法	中華民國	I440059	發明	20140601	20320509	獲證	100%	
	104	P51000168	P51000168US	自組裝設備、使元件自組裝的方法以及熱電元件組裝方法	美國	8609454	發明	20131217	20320716	獲證	100%	
50	105	P51010098	P51010098TW	內藏電容模組	中華民國	I510152	發明	20151121	20330709	獲證	100%	
51	106	P51020068	P51020068US	嵌入式電阻元件的半導體基板	美國	9343393	發明	20160517	20330311	獲證	100%	

案次	件次	案編號	件編號	中文專利名稱	國家	公告號	專利種類	專利起期	專利迄期	狀態	本案讓與專利權比例	契約運用
52	107	P51950074	P51950074CN	內藏電感組件及其制造方法	中國大陸	CN101211689	發明	20110420	20261228	獲證	100%	
	108	P51950074	P51950074TW	內藏電感元件及其製造方法	中華民國	I303957	發明	20081201	20261210	獲證	100%	
53	109	P51950093	P51950093CN	電感元件	中國大陸	CN101295574	發明	20110727	20270424	獲證	100%	
	110	P51950093	P51950093TW	電感元件	中華民國	I347616	發明	20110821	20270321	獲證	100%	
	111	P51950093	P51950093US	電感元件	美國	7928824	發明	20110419	20291001	獲證	100%	
54	112	P51950191	P51950191CN	電容器元件及其制造方法	中國大陸	CN101295580	發明	20110720	20280110	獲證	100%	
	113	P51950191	P51950191JP	電容器元件及其製造方法	日本	4794538	發明	20110805	20271209	獲證	100%	
	114	P51950191	P51950191KR	電容器元件及其製造方法	韓國	10-0974634	發明	20100802	20271107	獲證	100%	
	115	P51950191	P51950191TW	電容器元件及其製造方法	中華民國	I384513	發明	20130201	20271211	獲證	100%	
	116	P51950191	P51950191USD1	電容器元件及其製造方法	美國	8035951	發明	20111011	20270822	獲證	100%	
55	117	P51960002	P51960002CN	電容器、包含該電容器的電路板及集成電路承載基板	中國大陸	CN101295585	發明	20120111	20280327	獲證	100%	
	118	P51960002	P51960002JPD1	電容器、包含該電容器之電路板及積體電路承載基板	日本	5339384	發明	20130816	20280330	獲證	100%	
	119	P51960002	P51960002TW	電容器、包含該電容器之電路板及積體電路承載基板	中華民國	I397089	發明	20130521	20280327	獲證	100%	
56	120	P51960020	P51960020TW	嵌入式電阻元件	中華民國	I370465	發明	20120811	20271029	獲證	100%	
	121	P51960020	P51960020US	嵌入式電阻元件	美國	7948355	發明	20110524	20290417	獲證	100%	
57	122	P51960024	P51960024CN	電感元件	中國大陸	CN101325115	發明	20120502	20270614	獲證	100%	
	123	P51960024	P51960024TWC1	電感元件	中華民國	I339548	發明	20110321	20280121	獲證	100%	
	124	P51960024	P51960024US	電感元件	美國	7884697	發明	20110208	20280225	獲證	100%	
58	125	P51960029	P51960029CN	懸吊式電感元件	中國大陸	CN101388274	發明	20120502	20270913	獲證	100%	
	126	P51960029	P51960029TW	懸吊式電感元件	中華民國	I402866	發明	20130721	20270828	獲證	100%	
59	127	P51960087	P51960087CNC1	階梯式電容結構、其制造方法、及應用其的基板	中國大陸	CN101458994	發明	20120926	20281209	獲證	100%	
	128	P51960087	P51960087JP	階梯式電容結構、其製造方法、及應用其之基板	日本	4985620	發明	20120511	20281120	獲證	100%	
	129	P51960087	P51960087TWC2	階梯式電容結構、其製造方法、及應用其之基板	中華民國	I389288	發明	20130311	20281119	獲證	100%	
59	130	P51960087	P51960087USC1	階梯式電容結構、其製造方法、及應用其之基板	美國	8227894	發明	20120724	20291121	獲證	100%	
60	131	P51960147	P51960147CN	電容器裝置和電路	中國大陸	CN101527199	發明	20120704	20290226	獲證	100%	

案次	件次	案編號	件編號	中文專利名稱	國家	公告號	專利種類	專利起期	專利迄期	狀態	本案讓與專利權比例	契約運用
	132	P51960147	P51960147TW	電容器裝置與電路	中華民國	I393155	發明	20130411	20290224	獲證	100%	
	133	P51960147	P51960147US	電容器裝置與電路	美國	8198538	發明	20120612	20301116	獲證	100%	
61	134	P51960148	P51960148CN	具有共偶電極面的電容器件	中國大陸	CN101527198	發明	20120516	20290222	獲證	100%	
	135	P51960148	P51960148TW	電容器模組	中華民國	I397933	發明	20130601	20290219	獲證	100%	
	136	P51960148	P51960148US	電容器模組	美國	8125761	發明	20120228	20300612	獲證	100%	
62	137	P51960149	P51960149CN	具有濾波器結構的電容器裝置	中國大陸	CN101562433	發明	20120620	20290226	獲證	100%	V
	138	P51960149	P51960149TW	電容裝置	中華民國	I397931	發明	20130601	20290226	獲證	100%	V
	139	P51960149	P51960149US	電容裝置	美國	8237520	發明	20120807	20310122	獲證	100%	V
63	140	P51970101	P51970101CN	電容結構	中國大陸	CN102024565	發明	20130102	20290914	獲證	100%	
	141	P51970101	P51970101TW	電容結構	中華民國	I467610	發明	20150101	20290722	獲證	100%	
	142	P51970101	P51970101US	電容結構	美國	8488299	發明	20130716	20310525	獲證	100%	
64	143	P51980075	P51980075CN	熱管式發電裝置、氫/氧氣產生設備與內燃機系統	中國大陸	CN102086785	發明	20130821	20291207	獲證	100%	
	144	P51980075	P51980075TW	熱管式發電裝置及具有其之氫/氧氣產生設備與內燃機系統	中華民國	I392795	發明	20130411	20291102	獲證	100%	
	145	P51980075	P51980075US	熱管式發電裝置及具有其之氫/氧氣產生設備與內燃機系統	美國	8438847	發明	20130514	20310428	獲證	100%	
65	146	P51990101	P51990101CN	立體式電感	中國大陸	CN102569249	發明	20140122	20301223	獲證	100%	
	147	P51990101	P51990101US	立體式電感	美國	8339233	發明	20121225	20310517	獲證	100%	
66	148	P51990110	P51990110CN	內藏電容基板模塊	中國大陸	CN102548210	發明	20150107	20301230	獲證	100%	
	149	P51990110	P51990110TW	內藏電容基板模組	中華民國	I405322	發明	20130811	20301228	獲證	100%	
	150	P51990110	P51990110US	內藏電容基板模組	美國	8941015	發明	20150127	20330122	獲證	100%	
	151	P51990110	P51990110USC1	內藏電容基板模組	美國	9013893	發明	20150421	20320205	獲證	100%	

（三）平面顯示技術 20 案 38 件。

案次	件次	案編號	件編號	中文專利名稱	國家	公告號	專利種類	專利起期	專利迄期	狀態	本案讓與專利權比例	契約運用
67	152	P08940046	P08940046CN	微塗布圖案打印方法及系統	中國大陸	CN1978201	發明	20101215	20251129	獲證	100%	
	153	P08940046	P08940046TW	微塗佈圖案列印方法及系統	中華民國	I274668	發明	20070301	20251121	獲證	100%	
68	154	P08940062	P08940062CN	圖形打印系統及其數據處理方法	中國大陸	CN100486813	發明	20090513	20251230	獲證	100%	
	155	P08940062	P08940062TW	圖形列印系統及其資料處理方法	中華民國	I287828	發明	20071001	20251229	獲證	100%	
	156	P08940062	P08940062US	圖形列印系統及其資料處理方法	美國	8248656	發明	20120821	20291029	獲證	100%	
69	157	P08940090	P08940090CN	微液滴噴印裝置	中國大陸	CN100475533	發明	20090408	20251230	獲證	100%	
	158	P08940090	P08940090US	微液滴噴印裝置及其製程	美國	7591517	發明	20090922	20270328	獲證	100%	
70	159	P08940100	P08940100CN	打印圖檔數據的修正方法	中國大陸	CN100488778	發明	20090520	20251230	獲證	100%	
	160	P08940100	P08940100CND1	打印圖檔數據的修正方法	中國大陸	CN101404711	發明	20101208	20251230	獲證	100%	
71	161	P61010007	P61010007TW	液晶顯示面板	中華民國	I485491	發明	20150521	20330124	獲證	50%	
	162	P61010007	P61010007US	液晶顯示面板	美國	9025120	發明	20150505	20330829	獲證	50%	
72	163	P61010014	P61010014US	顯示器	美國	9000452	發明	20150407	20320927	獲證	100%	
73	164	P61010029	P61010029TW	顯示面板	中華民國	I498651	發明	20150901	20330619	獲證	50%	
	165	P61010029	P61010029US	顯示面板	美國	9140937	發明	20150922	20331229	獲證	50%	
74	166	P61010074	P61010074TW	顯示裝置	中華民國	I526320	發明	20160321	20330619	獲證	100%	V
75	167	P61020015	P61020015CN	電濕潤顯示器及基板的製作方法、設備、組立設備與系統	中國大陸	CN104216106	發明	20170412	20340226	獲證	100%	V
	168	P61020015	P61020015TW	電濕潤顯示器及其基板的製作方法、設備、組立設備與系統	中華民國	I502217	發明	20151001	20331230	獲證	100%	V
76	169	P61950015	P61950015TW	噴墨系統與噴墨控制方法	中華民國	I295633	發明	20080411	20260720	獲證	100%	
77	170	P61950038	P61950038CN	打印數據處理裝置及其方法	中國大陸	CN101214756	發明	20100811	20270104	獲證	100%	
	171	P61950038	P61950038TW	列印資料處理裝置及其方法	中華民國	I320754	發明	20100221	20261109	獲證	100%	
	172	P61950038	P61950038US	列印資料處理裝置及其方法	美國	7637578	發明	20091229	20280707	獲證	100%	
78	173	P61950039	P61950039TW	列印方法	中華民國	I318176	發明	20091211	20261107	獲證	100%	
	174	P61950039	P61950039US	列印方法	美國	7458658	發明	20081202	20270325	獲證	100%	
79	175	P61950061	P61950061TW	噴印資料計算方法及儲存媒體	中華民國	I327047	發明	20100701	20270320	獲證	100%	
80	176	P61960020	P61960020TW	供應系統	中華民國	I341260	發明	20110501	20280417	獲證	100%	
	177	P61960020	P61960020TWD1	噴頭結構	中華民國	I516310	發明	20160111	20280417	獲證	100%	

案次	件次	案編號	件編號	中文專利名稱	國家	公告號	專利種類	專利起期	專利迄期	狀態	本案讓與專利權比例	契約運用
	178	P61960020	P61960020US	供應系統	美國	8172387	發明	20120508	20301217	獲證	100%	
81	179	P61970041	P61970041TW	噴墨頭清洗裝置及方法	中華民國	I394664	發明	20130501	20290630	獲證	100%	
82	180	P61970046	P61970046TW	列印信號產生系統與方法	中華民國	I403698	發明	20130801	20290302	獲證	100%	
	181	P61970046	P61970046US	列印信號產生系統與方法	美國	8567893	發明	20131029	20310128	獲證	100%	
83	182	P61980029	P61980029TW	噴墨總成和噴墨機台	中華民國	I480175	發明	20150411	20300105	獲證	100%	
84	183	P61990011	P61990011CN	電濕潤像素結構	中國大陸	CN102346298	發明	20130515	20300803	獲證	100%	V
	184	P61990011	P61990011TWC1	電濕潤畫素結構	中華民國	I422858	發明	20140111	20300727	獲證	100%	V
	185	P61990011	P61990011US	電濕潤畫素結構	美國	8213090	發明	20120703	20301125	獲證	100%	V
85	186	P61990068	P61990068TW	彩色濾光片與影像感測器	中華民國	I434404	發明	20140411	20301206	獲證	100%	
86	187	P61990090	P61990090CN	顯示裝置	中國大陸	CN102841472	發明	20150520	20320612	獲證	50%	
	188	P61990090	P61990090TW	顯示裝置	中華民國	I483047	發明	20150501	20320612	獲證	50%	
	189	P61990090	P61990090US	顯示裝置	美國	8736800	發明	20140527	20321006	獲證	50%	

（四）軟性電子 11 案 14 件

案次	件次	案編號	件編號	中文專利名稱	國家	公告號	專利種類	專利起期	專利迄期	狀態	本案讓與專利權比例	契約運用
87	190	P51000020	P51000020TW	軟性基板結構及其製造方法	中華民國	I424797	發明	20140121	20310831	獲證	100%	
88	191	P51000030	P51000030US	一種單基板太陽能電池模組結構	美國	9076900	發明	20150707	20340506	獲證	100%	
89	192	P51000123	P51000123US	壓力感測器的電性量測裝置及其方法	美國	8776607	發明	20140715	20321110	獲證	100%	V
90	193	P51000174	P51000174CN	生理信號感測結構及其聽診器以及其制造方法	中國大陸	CN103417240	發明	20150513	20320611	獲證	100%	V
	194	P51000174	P51000174US	生理訊號感測結構及包括所述生理訊號感測結構的聽診器及其製造方法	美國	9226725	發明	20160105	20340412	獲證	100%	V
91	195	P51010103	P51010103US	可撓式超音波致動裝置	美國	9132263	發明	20150915	20331229	獲證	100%	
92	196	P51010188	P51010188TW	軟性電子元件模組及其拼接結構	中華民國	I549576	發明	20160911	20330613	獲證	100%	V
	197	P51010188	P51010188US	軟性電子元件模組	美國	9247653	發明	20160126	20340514	獲證	100%	
93	198	P51960067	P51960067TW	可撓式揚聲器結構	中華民國	I406573	發明	20130821	20270904	獲證	100%	
94	199	P51980009	P51980009US	靜電式揚聲器	美國	8594349	發明	20131126	20320926	獲證	100%	V
95	200	P51980137	P51980137TW	具有散熱結構之平面式揚聲器裝置以及平面揚聲器之散熱方法	中華民國	I469651	發明	20150111	20300307	獲證	100%	
96	201	P61020028	P61020028TWC1	電子式攝影成像系統與方法	中華民國	I562343	發明	20161211	20341202	獲證	100%	
	202	P61020028	P61020028US	電磁波感測元件、應用此感測元件的電子式攝影成像裝置與方法	美國	9268032	發明	20160223	20341202	獲證	100%	
97	203	P61990050	P61990050TWC1	用以感測施力之感測裝置	中華民國	I461668	發明	20141121	20310823	獲證	100%	

【備註】：本標案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。